

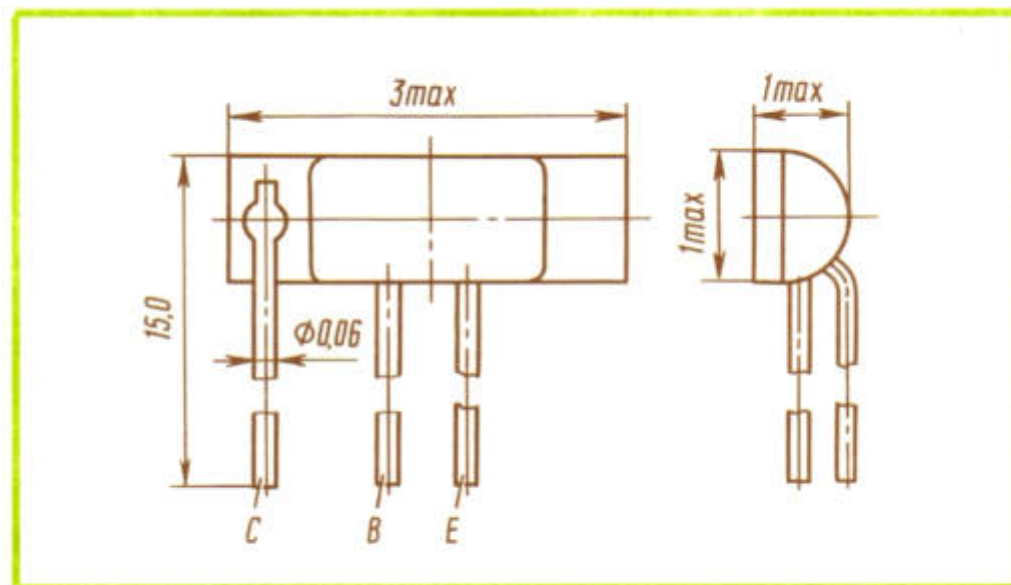
ТРАНЗИСТОРЫ МАЛОЙ МОЩНОСТИ ВЫСОКОЙ ЧАСТОТЫ LOW-POWER HIGH-FREQUENCY TRANSISTORS

KT384AM-2

Транзисторы KT384AM-2 предназначены для использования в неремонтируемых гибридных схемах, микромодулях, узлах и блоках, имеющих герметичную защиту от действий солнечного света, влаги, соляного тумана, плесневых грибов, повышенного и пониженного атмосферного давления, используемых в устройствах широкого применения.

Si-n-p-n-EP

The KT384AM-2 transistors are designed for use in non-repairable hybrid circuits, micromodules, assemblies and subassemblies which are hermetically protected against the effects of sunlight, humidity, salt spray, mould fungi, high and low atmospheric pressure. The devices are intended for use in a wide range of applications.



МАКСИМАЛЬНО ДОПУСТИМЫЕ ДАННЫЕ $t_{case} = -45...+85^{\circ}C$
MAXIMUM RATINGS

$I_{Cmax.}, A$	0,3
$I_{CMmax.} (t_p \leq 5 \mu s; Q \geq 10), A$	0,5
$U_{CBmax.}, V$	30
$U_{EBmax.}, V$	4

KT384AM-2

$U_{CE\text{ max.}}$ ($R_{BE} = 5\text{ k}\Omega$), V	30
$P_C\text{ max.}$ ($t_{\text{case}} \leq 70^\circ\text{C}$), W	0,3
$P_C\text{ max.}$ ($t_{\text{case}} = 85^\circ\text{C}$), W	0,2
$t_j\text{ max.}$, $^\circ\text{C}$	120

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ ELECTRICAL PARAMETERS

Параметры Parameters	KT384AM-2	Режимы Conditions
1	2	3
I_{CBO} , μA	≤ 10	$U_{CB} = 30\text{ V}$
I_{EBO} , μA	≤ 10	$U_{EB} = 4\text{ V}$

1	2	3
h_{21E}	30–180	$U_{CE} = 1\text{ V}$ $I_C = 150\text{ mA}$
$U_{CE\text{ sat}}$, V	$\leq 0,6$	$I_B = 15\text{ mA}$ $I_C = 150\text{ mA}$
$ h_{21e} $	$\leq 4,5$	$U_{CE} = 10\text{ V}$ $I_C = 100\text{ mA}$ $f = 10^5\text{ Hz}$
t_s , ns	≤ 15	$I_{B1} = I_{B2} = 15\text{ mA}$ $I_C = 150\text{ mA}$

